

Market News

600 V CoolMOS™ CFD7 SJ MOSFET hebt die Leistungsgrenze auf ein neues Level

München, 21. November 2017 – Mit dem 600 V CoolMOS™ CFD7 stellt die Infineon Technologies AG die neueste Hochvolt-Superjunction-MOSFET-Technologie vor. Damit wird die CoolMOS 7 Serie komplettiert. Die neue Produktfamilie adressiert den Hochleistungs-SMPS-Markt für resonante Topologien. Sie überzeugt mit branchenführender Effizienz und Zuverlässigkeit in Soft-Switching-Topologien wie LLC und ZVS PSFB. Dies ist perfekt geeignet für Hochleistungs-SMPS-Anwendungen wie [Server](#), [Telekommunikations-](#) und [EV-Ladeeinrichtungen](#).

Der 600 V CoolMOS CFD7 ist der Nachfolger des CoolMOS CFD2. Der neue MOSFET ist bis zu 1,45 Prozent effizienter als sein Vorgänger und vergleichbare Konkurrenzangebote. Er vereint alle Vorteile einer schnellen Schalttechnologie mit hoher Kommutierungsrobustheit und bietet zugleich eine komfortable Implementierung. Zu den wichtigsten Merkmalen des 600 V CoolMOS CFD7 gehören eine reduzierte Gate-Ladung (Q_g) und ein verbessertes Abschaltverhalten. Hinzu kommt eine Sperrverzögerungsladung (Q_{rr}), die bis zu 69 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Produkten auf dem Markt. Der 600 V CoolMOS CFD7 bietet branchenführende Lösungen für THD- und SMD-Bauelemente, die Lösungen mit hoher Leistungsdichte unterstützen.

Verfügbarkeit

Der 600 V CoolMOS CFD7 ist ab sofort im Hochvolumen verfügbar, Muster können bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/cfd7.